



بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
۱۶-۱۵ بهمن ۱۳۹۸



طراحی و بهینه سازی نانو حسگر دما فوتونیک کریستالی

پردیس کاظمی اسفه، زهرا اعلائی*

دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

Email: kazemipardis@gmail.com

Email: alaie.zahra@yahoo.com

چکیده - در این مقاله، ما تلاش به بهینه سازی یک نانو حسگر فوتونیک کریستالی برای سنجش دما در محدوده ۰ تا ۵۴۰ درجه سانتی گراد، نموده ایم. این نانو حسگر توسط دو موجبر و یک رزوناتور حلقه شش ضلعی طراحی شده است و در یک شبکه شش ضلعی فوتونیک کریستالی قرار دارد. ماکزیمم پارامترهای عملیاتی فاکتور کیفیت، حساسیت دما و بازده انتقال به ترتیب برابر ۶۲۸/۷۴، ۶۵/۵۵ pm/°C و ۱۰۰٪ است و از کیفیت بالایی برخوردار هستند. ابعاد نانو حسگر طراحی شده فشرده و کوچک می باشد، بنابراین برای استفاده در مدارهای مجتمع نوری بسیار مناسب است.

کلید واژه- حساسیت دما، سنسور دما فوتونیک کریستالی، سنسور نوری، فوتونیک کریستال.

Design and optimization of photonic crystal nano temperature sensor

Pardis Kazemi Esfeh, Zahra Alaei*

Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

Email: kazemipardis@gmail.com

Email: alaie.zahra@yahoo.com

Abstract- In this article we try to optimization photonic crystal nano sensor for sensing temperature from 0 to 540 degrees centigrade. **This nano sensor designed with two waveguides and one hexagonal ring resonator in hexagonal photonic crystal lattice. Maximum operation parameters: quality factor, temperature sensitivity, and transmission efficiency are 628.74, 65.55 pm/°C, and 100%, respectively; hence, these are good quality. The dimensional of designed nano sensor is compact and small, so it is very suitable for optical integrated circuits.**

Keywords: Optical Sensor, Photonic Crystal, Photonic Crystal Temperature Sensor, Temperature Sensitivity.

مقدمه

حسگرهای مورد استفاده در صنایع در حساسیت و محدوده اندازه‌گیری و همچنین توان انتقال دارای محدودیت‌هایی می‌باشند. با توجه به توسعه صنایع که نیازمند توانایی عملکرد بالاتری از حسگرها می‌باشد، تحقیقات بر روی حسگرهای فوتونیک کریستالی گسترش یافته است. حسگرهای فوتونیک کریستالی دارای مزیت‌هایی از جمله تلفات کم، سرعت بالا، قدرت بالا و ابعاد کوچک می‌باشند.

حسگر، پارامترهای فیزیکی و پارامترهای بیولوژیکی را حس کرده و تحلیل می‌کند و طبق آن‌ها پاسخ می‌دهد. تاکنون، حسگرهای مختلف الکترونیکی بسیاری طراحی شدند، اما این حسگرها محدودیت‌هایی دارند، که این محدودیت‌ها با توسعه حسگرهای نوری کاهش یافته یا از بین می‌روند [۱-۲]. در این مقاله، یک نانو حسگر فوتونیک کریستالی برای سنجش دما در محدوده ۰ تا ۵۴۰ درجه سانتی‌گراد طراحی گردیده است و همچنین تلاش بر این شده است که این نانو حسگر دارای کیفیت بالا از لحاظ فاکتور کیفیت، بازده انتقال و حساسیت باشد. نانو حسگر دما پیشنهاد شده در این مقاله، مبتنی بر فوتونیک کریستال‌های دوبعدی می‌باشد و در محدوده نانومتر کار می‌کند، همچنین شامل یک رزوناتور حلقه شش ضلعی و دو موجبر است.

ساختار مقاله به این صورت است که در قسمت دوم، به بیان روش سنجش حسگر فوتونیک کریستالی دما پرداخته شده است. در قسمت سوم، طراحی ساختار و بررسی شکاف باند فوتونی نانو حسگر دما فوتونیک کریستالی مبتنی بر رزوناتور حلقه شش ضلعی با روش بسط امواج تخت (PWE)^۱ انجام شده است. در قسمت چهارم، شبیه‌سازی و بررسی نتایج نانو حسگر دما فوتونیک کریستالی با روش تفاضل محدود

در حوزه زمان (FDTD)^۲ ارائه شده است، و در قسمت آخر مقاله با نتیجه‌گیری به پایان رسیده است.

روش سنجش و طراحی حسگر دما فوتونیک

کریستالی

حسگر دما مبتنی بر تغییرات ضریب شکست است و با توجه به اثر ترموپتیک سنجش را انجام می‌دهد. زمانی که دمای حسگر افزایش می‌یابد، ضریب شکست تغییر می‌کند که منجر به تغییر شکاف باند فوتونی و طول موج رزونانس ساختار فوتونیک کریستال می‌شود. به طور معمول، رابطه‌ی بین ضریب شکست و دما با توجه به رابطه (۱) به دست می‌آید [۳-۴]:

$$n = n_0 + \alpha \Delta T \quad (1)$$

در این رابطه، n_0 ضریب شکست بدون اعمال دما، α ضریب ترموپتیک می‌باشد که مقدار آن برای سیلیکون $10^{-4} \times 2/4$ است، و ΔT اختلاف دما است [۳-۴]. با افزایش دما، ضریب شکست سیلیکون به صورت خطی افزایش می‌یابد. بنابراین طول موج رزونانس نیز به طور خطی افزایش می‌یابد.

طراحی ساختار و بررسی شکاف باند فوتونی نانو

حسگر دما فوتونیک کریستالی

ساختار نانو حسگر پیشنهاد شده شامل میله‌های دایره‌ای سیلیکونی با ضریب شکست $n = 3/42$ هستند که در بستری از هوا با ضریب شکست $n = 1$ در یک شبکه شش ضلعی فوتونیک کریستالی قرار گرفته‌اند. همانطور که در شکل (۱) نشان داده شده است، تعداد میله‌های سیلیکونی در ساختار فوتونیک کریستالی در جهت X و Z ، به ترتیب ۱۹ و ۱۷ است. شعاع میله‌ها $r = 241/5$ nm و ثابت شبکه $a = 805$ nm است. همچنین شعاع میله‌های زرد رنگ، که میله‌های داخلی حلقه رزوناتور نامیده می‌شوند، برابر

² Finite Difference Time Domain

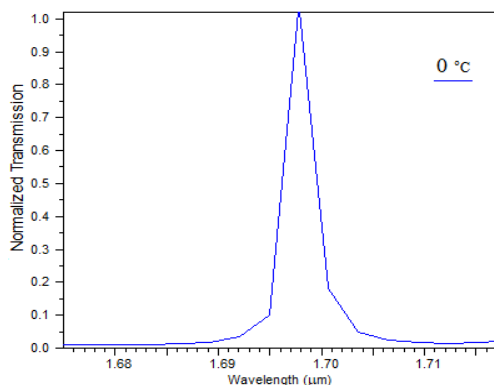
¹ Plane Wave Expansion

جدول (۱): فرکانس و طول موج نمودار شکاف باند فوتونی نانوسرگرم فوتونیک کریستالی.

شکاف باند فوتونی	فرکانس (a/λ)	طول موج (λ) (nm)
TE	۰/۷۱۲ - ۰/۷۸۹	۱۰۲۰ - ۱۱۳۰
TE	۰/۴۶۲ - ۰/۵۷۳	۱۴۰۵ - ۱۷۴۲
TM	۰/۳۹۹ - ۰/۴۱۷	۱۹۳۰ - ۲۰۱۷
TE	۰/۲۴۳ - ۰/۳۶۰	۲۲۳۶ - ۳۳۱۳

شبیه سازی و بررسی نتایج ساختار نانوسرگرم

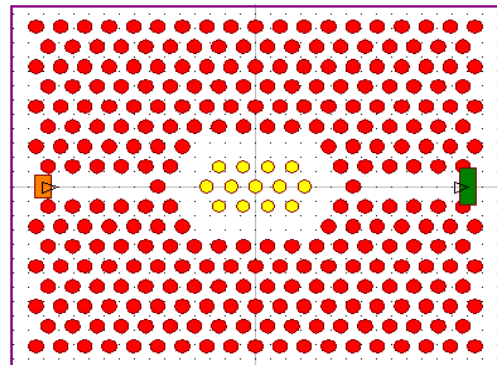
سنجش دما در ساختارهای فوتونیک کریستالی مبتنی بر تغییرات ضریب شکست می‌باشد، با تغییر دما، ضریب شکست به طور خطی تغییر می‌نماید و همچنین موجب تغییر طول موج رزونانس به طور خطی می‌شود. توسط روش FDTD، طیف نرمالیزه شده خروجی از رزوناتور حلقه شش ضلعی فوتونیک کریستالی، بدون اعمال دما (0°C)، در شکل (۳) نشان داده شده است، در این نمودار طول موج رزونانس $1697/6 \text{ nm}$ ، بازده انتقال 100% و فاکتور کیفیت آن $628/74$ می‌باشد.



شکل (۳): طیف نرمالیزه شده خروجی نانوسرگرم بدون اعمال دما.

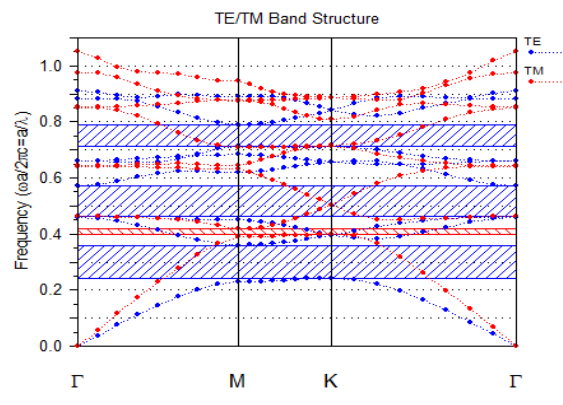
برای بررسی اثر دما بر روی نانوسرگرم طراحی شده، نمودار طیف‌های نرمالیزه شده خروجی در دماهای مختلف در محدوده 0 تا 540 درجه سانتی‌گراد در شکل (۴) نشان داده شده است. این محدوده‌ی بسیار بالای دمایی برای استفاده در صنایع مختلف به خصوص صنعت پتروشیمی مناسب می‌باشد. لازم به ذکر است که به دلیل تاثیرات جبران‌ناپذیر

$r_{in} = 210 \text{ nm}$ می‌باشد. ابعاد ساختار بسیار فشرده و کوچک بوده و برابر $204/12 \mu\text{m}^2$ است.



شکل (۱): ساختار نانوسرگرم دما فوتونیک کریستالی.

شکاف باند فوتونی نانوسرگرم دما فوتونیک کریستالی طراحی شده با استفاده از روش PWE بدست آمده است و نمودار آن در شکل (۲) نشان داده شده است. بدست آوردن شکاف باند فوتونی بسیار مهم می‌باشد زیرا توسط آن مقادیر بهینه برای طراحی نانوسرگرم دما کریستالی دما به دست می‌آید.



شکل (۲): نمودار شکاف باند فوتونی نانوسرگرم دما فوتونیک کریستالی.

نمودار نمایش داده شده در شکل (۲)، دارای سه شکاف باند TE و یک شکاف باند TM است که مقادیر دقیق آن‌ها در جدول (۱) آمده است. ما در این مقاله از شکاف باند TE با مقادیر طول موج 1405 nm تا 1742 nm ، استفاده می‌کنیم. زیرا در محدوده طول موج‌های پنجره سوم مخابراتی قرار دارد و برای طراحی نانوسرگرم دما مناسب می‌باشد.

جدول (۲): پارامترهای عملیاتی نانو حسگر در دماهای مختلف.

دما (°C)	ضریب شکست (RIU)	طول موج رزونانس (nm)	راندمان انتقال (%)	فاکتور کیفیت	حساسیت دما (pm/°C)
۰	۳/۴۲	۱۶۹۷/۶	۱۰۰	۶۲۸/۷۴	...
۱۸۰	۳/۴۶۳۲	۱۷۰۹/۴	۹۶/۵۵	۵۶۹/۸	۶۵/۵۵
۳۶۰	۳/۵۰۶۴	۱۷۲۱/۲	۹۷/۴۲	۵۹۳/۴۸	۶۵/۵۵
۵۴۰	۳/۵۴۹۶	۱۷۳۳	۱۰۰	۶۱۸/۹۳	۶۵/۵۵

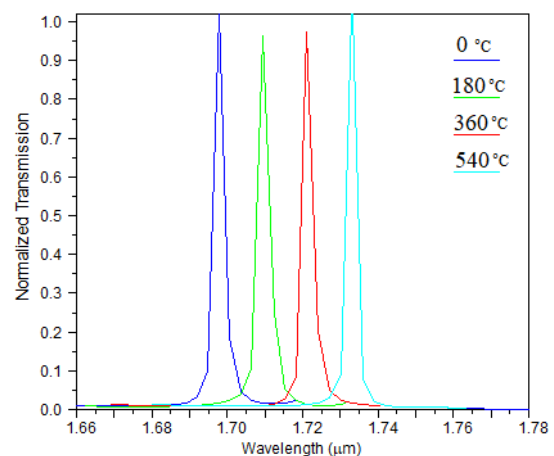
نتیجه گیری

در این مقاله، یک نانو حسگر دما در یک شبکه شش ضلعی فوتونیک کریستالی طراحی شد که با توجه به ابعاد و پارامترهای عملیاتی از کیفیت خوبی برخوردار است. بازده انتقال، فاکتور کیفیت و حساسیت دما در بهترین حالت به ترتیب برابر ۱۰۰٪ و ۶۲۸/۷۴ و ۶۵/۵۵ pm/°C است. ابعاد این نانو حسگر برابر $204/12 \mu\text{m}^2$ می باشد، که به علت فشرده بودن و سایز کم بسیار مناسب و قابل استفاده برای مدارهای مجتمع نوری است.

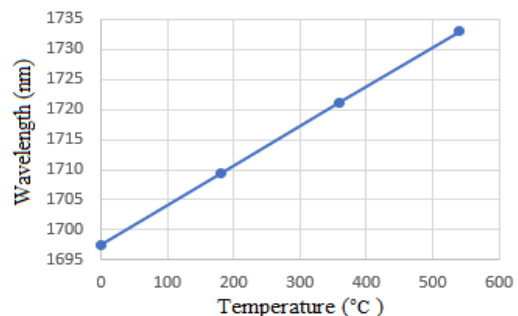
مرجع ها

- [۱] کاظمی اسفیه، اعلائی، نانو سنسور دما مبتنی بر فوتونیک کریستال های دو بعدی با وضوح تشخیص بالا، هشتمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی، ۱۳۹۸.
- [2] T. Dharchana, A. Sivanantharaja, S. Selvendran, "Design of Pressure Sensor Using 2D Photonic Crystal," Advances in Natural and Applied Sciences, pp. 26-30, 2017.
- [3] MT. Tinker, JB. Lee, "Thermal and optical simulation of a photonic crystal light modulator based on the thermo-optic shift of the cut-off frequency," Optics Express, pp. 7174-7188, 2005.
- [4] R. Rajasekar, S. Robinson, "Nano-Pressure and Temperature Sensor Based on Hexagonal Photonic Crystal Ring Resonator," Plasmonics. 14. 1-13. 2018.
- [5] J. Boruah, Y. Kalra, RK. Sinha, "Demonstration of temperature resilient properties of 2D silicon carbide photonic crystal structures and cavity modes," Optik, pp. 1663-1666, 2014.
- [6] Fu. H-w, H. Zhao, X-g. Qiao, Y. Li, D-z. Zhao, Z. Yong, "Study on a novel photonic crystal temperature sensor," Optoelectron Letters, pp. 419-422, 2011.

دمایی در دماهای بسیار بالا و اثرات ناچیز آن ها در گام های دمایی پایین، گام های دمایی انتخاب شده در این مقاله ۱۸۰ درجه سانتی گراد می باشد. با توجه به شکل (۵)، طبق انتظار، مشاهده می شود که با افزایش دما، طول موج رزونانس نیز به طور خطی تغییر می کند و به منطقه ای با طول موج های بالاتر انتقال می یابد. اختلاف هر کدام از طیف های رزونانس خروجی نرمالیزه $11/8 \text{ nm}$ می باشد. طول موج رزونانس بازده انتقال، فاکتور کیفیت و حساسیت دما از حسگر طراحی شده در سطوح مختلف دما در جدول (۲) آورده شده است. با توجه به جدول، حداکثر بازده انتقال، فاکتور کیفیت و حساسیت دما به ترتیب ۱۰۰٪، ۶۲۸/۷۴ و $65/55 \text{ pm}/^\circ\text{C}$ است. همچنین نتایج بدست آمده از این ساختار به خصوص فاکتور کیفیت نسبت به مراجع [۱]، [۲] و [۵] که فاکتور کیفیت آن ها به ترتیب برابر $582/66$ ، 150 و 213 می باشد، بهبود یافته و از کیفیت بالاتری برخوردار است.



شکل (۴): طیف های رزونانس خروجی نرمالیزه برای دماهای ۰ تا ۵۴۰ درجه سانتی گراد.



شکل (۵): رابطه ی خطی بین طول موج و دما.